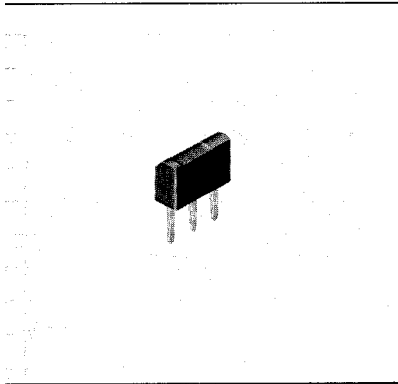
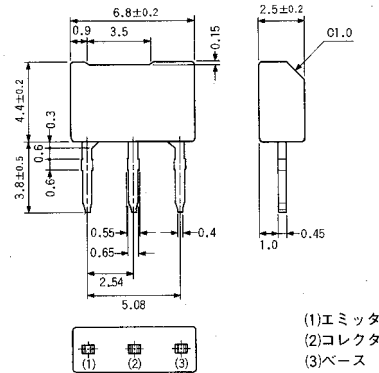


# 2SD1226M

トランジスタ



●外形寸法図



(単位: mm)

図1 ATR

●特長

- 1) 小型のATRパッケージにて  $P_c=1W$  である。
- 2) 高耐圧、大電流である。  
 $V_{CE0}=80V$ 、 $I_C \text{ MAX}=700mA$
- 3) 2SB910Mとコンプリである。

●用途

$P_c=60W$ クラスまでのドライバー

●絶対最大定格 ( $T_a=25^\circ C$ )

項目	記号	最大定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	700	mA dc.
		1	A (Pulse)*
コレクタ損失	$P_C$	1	W
接合部温度	$T_j$	135	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~135	$^\circ C$

\*  $P_w=20ms$ ,  $duty=1/2$

●電気的特性 ( $T_a=25^\circ C$ )

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CE0}$	80	—	—	V	$I_C=2mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CB0}$	80	—	—	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EB0}$	5	—	—	V	$I_E=50\mu A$
コレクタシャ断電流	$I_{CB0}$	—	—	0.5	$\mu A$	$V_{CB}=50V$
エミッタシャ断電流	$I_{EB0}$	—	—	0.5	$\mu A$	$V_{EB}=4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.2	0.4	V	$I_C/I_B=500mA/50mA$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C=3V/100mA$
利得帯域幅積(トランジション周波数)	$f_T$	—	120	—	MHz	$V_{CE}=10V, I_C=50mA$
出力容量	$C_{ob}$	—	10	—	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$

$h_{FE}$ の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
$h_{FE}$	82~180	120~270	180~390